Стенд для исследования биполярных структур ЭЛБ-150.008.01

Позволяет реализовать цикл лабораторных работ:
-Измерение ВАХ p–n
-перехода и сравнение еѐ с идеальной характеристикой.
-Исследование прямой ветви ВАХ различных схем диодного включения транзистора при различных температурах.
-Измерение обратной ветви ВАХ электронно-дырочного перехода при различных температурах. Исследование явления пробоя.
-Измерение входных характеристик транзистора при различных напряжениях на коллекторе и различных температурах.
-Исследование семейства выходных характеристик транзистора при различных температурах.
-Передаточные характеристики и характеристики обратной связи биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.